

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выбор баз данных
Параметры поиска
Формулировка запроса
Уточненный запрос
Найденные документы
Корзина
Сохраненные запросы
Статистика
Помощь
Предложения
Выход

Статус	по данным на 25.07.2008 - прекратил действие
(11) Номер публикации	2204179
(13) Вид документа	C1
(14) Дата публикации	2003.05.10 <input type="button" value="Печать"/>
(19) Страна публикации	RU
(21) Заявка	2002121964/28
(22) Дата подачи заявки	2002.08.19
(24) Дата начала отсчета срока действия патента	2002.08.19
(45) Опубликовано	2003.05.10 <input type="button" value="Печать"/>
(516) Номер редакции МПК	7
(51) Основной индекс МПК	H01L21/265 <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value="МПК"/>
Название	METHOD FOR SHAPING NANOTOPOGRAPHY ON FILM SURFACE
(71) Заявитель(и)	Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "Agentstvo marketinga nauchnykh razrabotok" <input type="button" value="Печать"/>
(72) Автор(ы)	Smirnov V.K. <input type="button" value="Печать"/>
(72) Автор(ы)	Kibalov D.S. <input type="button" value="Печать"/>
(73) Патентообладатель(и)	Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "Agentstvo marketinga nauchnykh razrabotok" <input type="button" value="Печать"/>

Адрес для переписки

111250, Moskva, ul.
Aviamotornaja, 53, ZAO
"Patentnyj poverennyj", pat. pov.
G.N. Andrushchak, reg.№ 189

ДОКУМЕНТ
в начало
в конец
в корзину
печать
ТЕРМИНЫ
предыдущий
следующий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выбор баз данных
Параметры поиска
Формулировка запроса
Уточненный запрос
Найденные документы
Корзина
Сохраненные запросы
Статистика
Помощь
Предложения
Выход

Библиография	Рисунок
--------------	---------

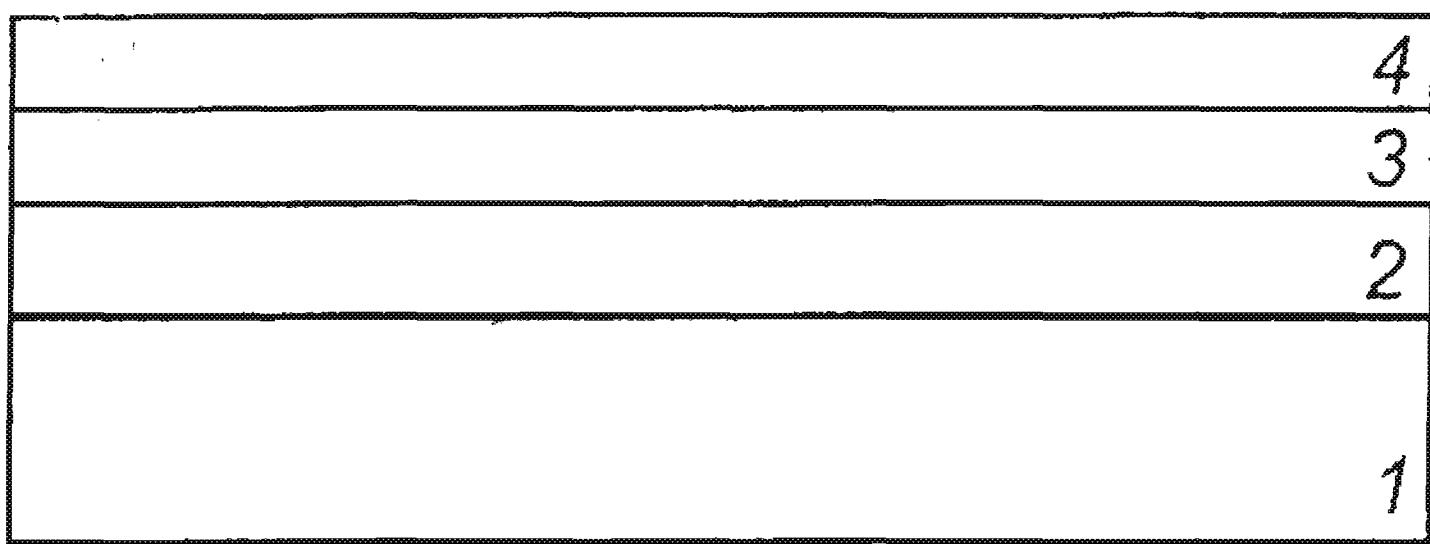
№2204179. Реферат

FIELD: microelectronics engineering. SUBSTANCE: method involves covering film surface with silicon layer whose thickness equals one and a half to three depths of nanostructure formation in silicon layer; spraying silicon surface with stream of nitrogen molecule ions in vacuum, nitrogen ion energy, nitrogen ion angle of flow relative to silicon surface, depth of nanostructure formation and nanostructure height being chosen basing on nanostructure wavelength ranging between 30 and 180 nm before formation of nanostructure spaced apart from film at one third of wavelength on nanostructure wave valleys with wave crest positioned perpendicular to projection of ion flow on silicon surface; transferring nanostructure topography to film surface with nanostructure and film materials being removed by ion-beam or plasma etching.

EFFECT: improved formation of nanotopography on film surface. 9 cl, 16 dwg

Библиография	Рисунок
--------------	---------

ДОКУМЕНТ
в начало
в конец
в корзину
печатать



Фиг. 1